

Одиночные MOSFET транзисторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tax@nt-rt.ru || сайт: <https://texas.nt-rt.ru>



CSD13202Q2

Полевой транзистор, N-канальный, 12 В, 76 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON6
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 22А
Сопротивление открытого канала: 9.3 мОм
Мощность макс.: 2.7Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В
Заряд затвора: 6.6нКл
Входная емкость: 997пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD13380F3

Производитель: Texas Instruments

CSD13381F4

Транзистор полевой N-канальный 12В 2.1А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 2.1А
Сопротивление открытого канала: 180 мОм
Мощность макс.: 500мВт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.:
1.1В Заряд затвора: 1.4нКл
Входная емкость: 200пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD13381F4T

Транзистор полевой N-канальный 12В 2.1А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 2.1А
Сопротивление открытого канала: 180 мОм
Мощность макс.: 500мВт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.:
1.1В Заряд затвора: 1.4нКл
Входная емкость: 200пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD15380F3

Trans MOSFETN-CH 20V 0.5A 3-Pin PicoStar T/R

Производитель: Texas Instruments

CSD15380F3T

Полевой транзистор N-канальный 20В 0.5А 3-Pin PicoStar лента на катушке

Производитель: Texas Instruments

Напряжение исток-сток макс.: 20В

Ток стока макс.: 0.5А

Тип транзистора: N-канал

CSD16301Q2

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON6

Напряжение исток-сток макс.: 25В

Ток стока макс.: 5А

Сопротивление открытого канала: 24 мОм

Мощность макс.: 2.3Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.55В

Заряд затвора: 2.8нКл

Входная емкость: 340пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD16321Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

CSD16322Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 25В

Ток стока макс.: 21А

Сопротивление открытого канала: 5 мОм

Мощность макс.: 3.1Вт

Тип транзистора: N-канал

Пороговое напряжение включения макс.: 1.4В

Заряд затвора: 9.7нКл

Входная емкость: 1365пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD16323Q3

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON-8

CSD16327Q3T

Полевой транзистор N-канальный 25В 21А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 60А
Сопротивление открытого канала: 4 мОм
Мощность макс.: 3Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.4В
Заряд затвора: 8.4нКл
Входная емкость: 1300пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16340Q3

Транзистор полевой N-канальный 25В 60А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 21А
Сопротивление открытого канала: 4.5 мОм
Мощность макс.: 3Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В
Заряд затвора: 9.2нКл
Входная емкость: 1350пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16340Q3T

Полевой транзистор N-канальный 25В 60А 8VSON
Производитель: Texas Instruments

CSD16401Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 100 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8
Напряжение исток-сток макс.: 25В

Ток стока макс.: 38А
Сопротивление открытого канала: 1.6 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В
Заряд затвора: 29нКл
Входная емкость: 4100пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16403Q5A

Транзистор полевой N-канальный 25В 100А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 28А
Сопротивление открытого канала: 2.8 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В
Заряд затвора: 18нКл
Входная емкость: 2660пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16404Q5A

Транзистор полевой N-канальный 25В 81А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 21А
Сопротивление открытого канала: 5.1 мОм
Мощность макс.: 3Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 2.1В
Заряд затвора: 8.5нКл
Входная емкость: 1220пФ
Тип монтажа: Surface Mount

Новинка

CSD16406Q3

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 25В 60А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON-8
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 19А
Сопротивление открытого канала: 5.3 мОм
Мощность макс.: 2.7Вт

Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.2В
Заряд затвора: 8.1нКл
Входная емкость: 1100пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16407Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 100 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 31А
Сопротивление открытого канала: 2.4 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В
Заряд затвора: 18нКл
Входная емкость: 2660пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16409Q3

Транзистор полевой N-канальный 25В 60А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 15А
Сопротивление открытого канала: 8.2 мОм
Мощность макс.: 2.6Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В
Заряд затвора: 5.6нКл
Входная емкость: 800пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16411Q3

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 56 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON (3.3x3.3)
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 14А
Сопротивление открытого канала: 10 мОм
Мощность макс.: 2.7Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В
Заряд затвора: 3.8нКл

Входная емкость: 570пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD16413Q5A

Транзистор полевой N-канальный 25В 100А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 25В
Ток стока макс.: 24А
Сопротивление открытого канала: 3.9 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В
Заряд затвора: 11.7нКл
Входная емкость: 1780пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17301Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 28 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP

CSD17302Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 87 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 16А
Сопротивление открытого канала: 7.9 мОм
Мощность макс.: 3Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 1.7В
Заряд затвора: 7нКл
Входная емкость: 950пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17303Q5

MOSFETN-CH 30V 100A 8SON
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON-8

CSD17306Q5A

Транзистор полевой N-канальный 30В 100А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 24А
Сопротивление открытого канала: 3.7 мОм
Мощность макс.: 3.2Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 1.6В
Заряд затвора: 15.3нКл
Входная емкость: 2170пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17307Q5A

Транзистор полевой N-канальный 30В 73А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 14А
Сопротивление открытого канала: 10.5 мОм
Мощность макс.: 3Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В
Заряд затвора: 5.2нКл
Входная емкость: 700пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17308Q3

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 47А 2.7Вт
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 47А
Мощность макс.: 2.7Вт
Тип транзистора: N-канальный

CSD17308Q3T

Транзистор полевой N-канальный 30В VSON 8
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 13А(Т_а), 47А(Т_с)
Сопротивление открытого канала: 10.3 мОм @ 10А, 8В
Мощность макс.: 2.7Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Standard
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В @ 250 μА
Заряд затвора: 5.1нКл @ 4.5В
Входная емкость: 700пФ @ 15В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17309Q3

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 60 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 20А

Сопротивление открытого канала: 5.4 мОм

Мощность макс.: 2.8Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.7В

Заряд затвора: 10нКл

Входная емкость: 1440пФ

Тип монтажа: Surface Mount

Новинка

CSD17310Q5A

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 21А/100А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: VSON8-HR

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 21А/100А

Тип транзистора: N-канальный

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17312Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 38А

Сопротивление открытого канала: 1.5 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.5В

Заряд затвора: 36нКл

Входная емкость: 5240пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17313Q2-Q1

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 5 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON6

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 5А
Сопrotивление открытого канала: 30 мОм
Мощность макс.: 2.3Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В
Заряд затвора: 2.7нКл
Входная емкость: 340пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17313Q2-Q1

Полевой транзистор N-канальный 30В 5А автомобильного применения 6-Pin
WSON EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments

CSD17313Q2Q1

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 5 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON6
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 5А
Сопrotивление открытого канала: 30 мОм
Мощность макс.: 2.3Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Automotive, Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В
Заряд затвора: 2.7нКл
Входная емкость: 340пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17318Q2

МОП-транзистор
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 25А
Тип транзистора: N-канальный
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17381F4T

Транзистор полевой N-канальный 30В 3.1А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 3.1А
Сопrotивление открытого канала: 109 мОм
Мощность макс.: 500мВт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В
Заряд затвора: 1.35нКл
Входная емкость: 195пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17382F4T

Транзистор полевой N-канальный 30В 2.3А 3-Pin PicoStar лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 2.3А
Тип транзистора: N-канал

CSD17483F4

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 1.5 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3

CSD17483F4T

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 1.5 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3

CSD17484F4T

МОП-транзистор 30V N-Ch FemtoFETМОП-транзистор
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Тип транзистора: N-канальный
Особенности: FemtoFET
Одиночные MOSFET транзисторы (98)

CSD17506Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 100 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 100А
Сопротивление открытого канала: 4 мОм
Мощность макс.: 3.2Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В
Заряд затвора: 11нКл
Входная емкость: 1650пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17522Q5A

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 16А 8-Pin SON EP лента на катушке

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 16А

Тип транзистора: N-канальный

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17552Q3A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 15 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 15А

Сопротивление открытого канала: 6 мОм

Мощность макс.: 2.6Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В

Заряд затвора: 12нКл

Входная емкость: 2050пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17552Q5A

Транзистор полевой N-канальный 30В 17А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: 8-VSON (5x6)

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 17А

Сопротивление открытого канала: 6.2 мОм

Мощность макс.: 3Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В

Заряд затвора: 12нКл

Входная емкость: 2050пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17559Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 40А

Сопротивление открытого канала: 1.15 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.7В
Заряд затвора: 51нКл
Входная емкость: 9200пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17571Q2
Полевой транзистор N-канальный 30В 22А 6SON
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 6-SON (2x2)

CSD17577Q3AT
Полевой транзистор N-канальный 30В 35А 8-Pin VSONP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSONP (3x3.15)
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 35А(Та)
Сопротивление открытого канала: 4.8 мОм @ 16А, 10В
Мощность макс.: 2.8Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В @ 250 μА
Заряд затвора: 35нКл @ 10В
Входная емкость: 2310пФ @ 15В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17579Q3A
Транзистор полевой N-канальный 30В 35А QFN
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSONP (3x3.15)
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 20А(Та)
Сопротивление открытого канала: 10.2 мОм @ 8А, 10В
Мощность макс.: 3.2Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В @ 250 μА
Заряд затвора: 15нКл @ 10В
Входная емкость: 998пФ @ 15В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17585F5
Полевой транзистор N-канальный 30В 5.9А 3-Pin PicoStar лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 30В
Ток стока макс.: 5.9А
Тип транзистора: N-канал

CSD18501Q5A

Транзистор полевой N-канальный 40В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 40В
Ток стока макс.: 22А
Сопротивление открытого канала: 3.2 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В
Заряд затвора: 50нКл
Входная емкость: 3840пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18503Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 40 В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 40В
Ток стока макс.: 19А
Сопротивление открытого канала: 4.3 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В
Заряд затвора: 32нКл
Входная емкость: 2640пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18504KCS

Транзистор полевой N-канальный 40В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: TO-220
Напряжение исток-сток макс.: 40В
Ток стока макс.: 53А
Сопротивление открытого канала: 7 мОм
Мощность макс.: 93Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В
Заряд затвора: 25нКл
Входная емкость: 1800пФ
Тип монтажа: Through Hole

CSD18504Q5A

Транзистор полевой N-канальный 40В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 40В
Ток стока макс.: 15А
Сопротивление открытого канала: 6.6 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.4В
Заряд затвора: 19нКл
Входная емкость: 1656пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18504Q5AT

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 40В 50А 77Вт
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 40В
Ток стока макс.: 50А
Мощность макс.: 77Вт
Тип транзистора: N-канальный

CSD18509Q5B

Trans MOSFET N-CH Si 40V 100A 8-Pin VSON-CLIP EPT/R
Производитель: Texas Instruments

CSD18509Q5BT

Полевой транзистор N-канальный 40В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 40В
Ток стока макс.: 100А
Сопротивление открытого канала: 1.2 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: ± 20 В
Заряд затвора: 195нКл
Входная емкость: 13900пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18531Q5A

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А 8-Pin VSONP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 19А(Т_а), 100А(Т_с)
Сопротивление открытого канала: 4.6 мОм @ 22А, 10В
Мощность макс.: 3.1Вт

Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В @ 250 µА
Заряд затвора: 43нКл @ 10В
Входная емкость: 3840пФ @ 30В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18532KCS

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А TO220-3
Производитель: Texas Instruments
Корпус: TO-220
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 100А(Тс)
Сопротивление открытого канала: 4.2 мОм @ 100А, 10В
Мощность макс.: 216Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.2В @ 250 µА
Заряд затвора: 53нКл @ 10В
Входная емкость: 4680пФ @ 30В
Тип монтажа: Through Hole

CSD18533Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 60 В, 17 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 17А
Сопротивление открытого канала: 5.9 мОм
Мощность макс.: 3.2Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В
Заряд затвора: 36нКл
Входная емкость: 2750пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18534Q5AT

Транзистор полевой N-канальный 60В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON (5x6)
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 13А
Сопротивление открытого канала: 9.8 мОм
Мощность макс.: 3.1Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В
Заряд затвора: 22нКл
Входная емкость: 1770пФ
Тип монтажа: Surface Mount
CSD18535KTTT
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 200А
Мощность макс.: 300Вт
Тип транзистора: N-канальный
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18537NKCS
Транзистор полевой N-канальный 60В 50А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: TO-220
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 50А
Сопротивление открытого канала: 14 мОм
Мощность макс.: 79Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 3.5В
Заряд затвора: 18нКл
Входная емкость: 1480пФ
Тип монтажа: Through Hole

CSD18537NQ5A
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 50А VSONP-8
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-SON (5x6)
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 11А(Т_а), 50А(Т_с)
Сопротивление открытого канала: 13 мОм @ 12А, 10В
Мощность макс.: 75Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 3.5В @ 250 μА
Заряд затвора: 18нКл @ 10В
Входная емкость: 1480пФ @ 30В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18537NQ5AT
Транзистор полевой N-канальный 60В 50А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON (5x6)
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 50А

Сопротивление открытого канала: 13 мОм
Мощность макс.: 75Вт
Тип транзистора: N-канал
Пороговое напряжение включения макс.: 3.5В
Заряд затвора: 18нКл
Входная емкость: 1480пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18540Q5B

Транзистор полевой MOSFET N-канальный Si 60В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 100А
Тип транзистора: N-канальный
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18540Q5B

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments

CSD18540Q5BT

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 100А
Тип транзистора: N-канал
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18541F5

Полевой транзистор N-канальный 60В 2.2А 3-Pin PicoStar лента на катушке
Производитель: Texas Instruments

CSD18543Q3A

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 35А 8-Pin VSONP EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: VSONP-8 (3.3 mm x 3.3)
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 35А
Тип транзистора: N-канал
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18563Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 60 В, 96 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 60В

Ток стока макс.: 15А

Сопротивление открытого канала: 6.8 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 2.4В

Заряд затвора: 20нКл

Входная емкость: 1500пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD18563Q5AT

Полевой транзистор, N-канальный, 60 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: 8-VSON (5x6)

Напряжение исток-сток макс.: 60В

Ток стока макс.: 100А

Сопротивление открытого канала: 6.8 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 2.4В

Заряд затвора: 20нКл

Входная емкость: 1500пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD19531KCS

Транзистор полевой N-канальный 100В 100А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: TO-220

Напряжение исток-сток макс.: 100В

Ток стока макс.: 100А

Сопротивление открытого канала: 7.7 мОм

Мощность макс.: 179Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 3.3В

Заряд затвора: 38нКл

Входная емкость: 3870пФ

Тип монтажа: Through Hole

CSD19532Q5BT

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 100А

Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)
Напряжение исток-сток макс.: 100В
Ток стока макс.: 100А
Тип транзистора: N-канальный
Тип монтажа: Surface Mount

CSD19533Q5A
Полевой транзистор, N-канальный, 100 В, 100 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP
Напряжение исток-сток макс.: 100В
Ток стока макс.: 100А
Сопротивление открытого канала: 11.1 мОм
Мощность макс.: 3.2Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В
Заряд затвора: 35нКл
Входная емкость: 2670пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD19533Q5AT
Полевой транзистор, N-канальный, 100 В, 100 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON8EP

CSD19534Q5A
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 137А 8SON
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)
Напряжение исток-сток макс.: 100В
Ток стока макс.: 50А(Ta)
Сопротивление открытого канала: 15.1 мОм @ 10А, 10В
Мощность макс.: 3.2Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В @ 250 μА
Заряд затвора: 22нКл @ 10В
Входная емкость: 1680пФ @ 50В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD19534Q5AT
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 137А 8SON
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)
Напряжение исток-сток макс.: 100В

Ток стока макс.: 50А(Ta)
Сопротивление открытого канала: 15.1 мОм @ 10А, 10В
Мощность макс.: 3.2Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В @ 250 μА
Заряд затвора: 22нКл @ 10В
Входная емкость: 1680пФ @ 50В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD19535KCS

Транзистор полевой N-канальный 100В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: TO-220
Напряжение исток-сток макс.: 100В
Ток стока макс.: 150А
Сопротивление открытого канала: 3.6 мОм
Мощность макс.: 300Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В
Заряд затвора: 101нКл
Входная емкость: 7930пФ
Тип монтажа: Through Hole

CSD19535KTT

Полевой транзистор N-канальный 100В 200А 4-Pin(3+Tab) TO-263 лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 100В
Ток стока макс.: 200А
Тип транзистора: N-канал
Тип монтажа: Surface Mount

CSD19535KTTT

Полевой транзистор N-канальный 100В 200А 4-Pin(3+Tab) TO-263 лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 100В
Ток стока макс.: 200А
Тип транзистора: N-канал
Тип монтажа: Surface Mount

CSD19536KCS

Транзистор полевой N-канальный 100В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: TO-220
Напряжение исток-сток макс.: 100В
Ток стока макс.: 150А

Сопrotивление открытого канала: 2.7 мОм
Мощность макс.: 375Вт
Тип транзистора: N-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 3.2В
Заряд затвора: 153нКл
Входная емкость: 12000пФ
Тип монтажа: Through Hole

CSD22205L

Транзистор полевой P-канальный 8В 7.4А 4-Pin PICOSTAR лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 8В
Ток стока макс.: 7.4А
Тип транзистора: P-канал

CSD23202W10

Транзистор полевой P-канальный 12В 2.2А 4DSBGA
Производитель: Texas Instruments
Корпус: DSBGA4
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 2.2А(Т_а)
Сопrotивление открытого канала: 53 мОм @ 500mA, 4.5В
Мощность макс.: 1Вт
Тип транзистора: P-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 900mВ @ 250 μА
Заряд затвора: 3.8нКл @ 4.5В
Входная емкость: 512пФ @ 6В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD23203WT

Полевой транзистор P-канальный 8В 3А 6DSBGA
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 6-DSBGA
Напряжение исток-сток макс.: 8В
Ток стока макс.: 3А(Т_а)
Сопrotивление открытого канала: 19.4 мОм @ 1.5А, 4.5В
Мощность макс.: 750мВт
Тип транзистора: P-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В @ 250 μА
Заряд затвора: 6.3нКл @ 4.5В
Входная емкость: 914пФ @ 4В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD23280F3T

Полевой транзистор P-канальный 12В 1.8А 3-Pin PicoStar лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 1.8А
Тип транзистора: P-канал

CSD23285F5

Полевой транзистор P-канальный 12В 5.4А 3-Pin PicoStar
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 5.4А
Тип транзистора: P-канал

CSD23381F4

Полевой транзистор P-канальный 12В 2.3А 3-Pin PicoStar лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 2.3А(Ta)
Сопротивление открытого канала: 175 мОм @ 500mA, 4.5В
Мощность макс.: 500мВт
Тип транзистора: P-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.2В @ 250 µА
Заряд затвора: 1.14нКл @ 4.5В
Входная емкость: 236пФ @ 6В
Тип монтажа: Surface Mount

CSD25310Q2

Транзистор полевой P-канальный 20В 20А 6-Pin WSON EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON6
Напряжение исток-сток макс.: 20В
Ток стока макс.: 20А
Сопротивление открытого канала: 23.9 мОм
Мощность макс.: 2.9Вт
Тип транзистора: P-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В
Заряд затвора: 4.7нКл
Входная емкость: 655пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD25402Q3A

Транзистор полевой MOSFET P-канальный 20В 72А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: VSONP-8 (3.3 mm x 3.3)

Напряжение исток-сток макс.: 20В
Ток стока макс.: 72А
Сопротивление открытого канала: 8.9 мОм
Мощность макс.: 2.8Вт
Тип транзистора: P-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.15В
Заряд затвора: 9.7нКл
Входная емкость: 1790пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD25481F4

Полевой транзистор P-канальный 20В 2.5А 3-Pin PicoStar лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3

CSD25481F4T

Полевой транзистор, P-канальный, 20 В, 2.5 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3

CSD25483F4

Полевой транзистор P-канальный 20В 1.6А 3-Pin PicoStar лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3
Напряжение исток-сток макс.: 20В
Ток стока макс.: 1.6А(Та)
Сопротивление открытого канала: 205 мОм @ 500mA, 8В
Мощность макс.: 500мВт
Тип транзистора: P-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.2В @ 250 µА
Заряд затвора: 0.959нКл @ 4.5В
Входная емкость: 198пФ @ 10В

CSD25483F4T

Полевой транзистор, P-канальный, 20 В
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SON3
Напряжение исток-сток макс.: 20В
Ток стока макс.: 1.6А
Сопротивление открытого канала: 205 мОм
Мощность макс.: 500мВт
Тип транзистора: P-канал
Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.2В

Заряд затвора: 0.96нКл
Входная емкость: 198пФ
Тип монтажа: Surface Mount

CSD83325L

Транзистор полевой N-канальный 12В 8А
Производитель: Texas Instruments
Напряжение исток-сток макс.: 12В
Ток стока макс.: 8А
Тип транзистора: N-канальный

CSD85301Q2

Транзистор полевой N-канальный 20В 5А 6-Pin WSON EP лента на катушке
Производитель: Texas Instruments
Корпус: WSON-6 (2x2)
Напряжение исток-сток макс.: 20В
Ток стока макс.: 5А
Сопротивление открытого канала: 27 мОм @ 5А, 4.5В
Мощность макс.: 2.3Вт
Тип транзистора: N-канальный
Тип монтажа: Surface Mount

CSD88537NDT

Полевой транзистор, 2N-канальный, 60 В, 15 А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SOIC8
Напряжение исток-сток макс.: 60В
Ток стока макс.: 15А
Тип транзистора: N-канал
Тип монтажа: Surface Mount

CSD97395Q4MT

Драйвер управления затвором High Freq Sync Buck NexFETPw Stage
Производитель: Texas Instruments
Корпус: 8-VSON (3.5x4.5)
Тип монтажа: Surface Mount

TPS1100D

Транзистор полевой P-канальный 15В 1.6А
Производитель: Texas Instruments
Корпус: SOIC8
Напряжение исток-сток макс.: 15В
Ток стока макс.: 1.6А
Сопротивление открытого канала: 180 мОм
Мощность макс.: 791мВт
Тип транзистора: P-канал

Особенности: Logic Level Gate
Пороговое напряжение включения макс.: 1.5В
Заряд затвора: 5.45нКл
Тип монтажа: Surface Mount

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tax@nt-rt.ru || сайт: <https://texas.nt-rt.ru>